反応性イオンエッチング装置

反応性イオンエッチング装置
サムコ㈱
RIE-400iPB-YK

平成２３年度導入

【主な用途・仕様】
シリコン（Si），SiO2 の垂直エッチング

- 試料サイズ：φ4 インチ以下
- エッチング速度：10μm / min（Si），500nm / min（SiO2）
- ビーム解像度：100nm（ビーム径＜100nm）
- マスク選択比：100：1（Si：ポジ型 PR，SiO2：Ni）

【設備使用】

【委託分析試験】　　マイクロマシニング加工（C）